МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зав. выпускающей кафедры

MEMS-технологии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Электронных приборов

Учебный план v11.04.04_24_00.plx

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация магистр

Форма обучения очно-заочная

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого		
Недель	1	0			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	20	20	20	20	
Лабораторные	10	10	10	10	
Практические	20	20	20	20	
Иная контактная работа	0,35	0,35	0,35	0,35	
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2	
Итого ауд.	52,35	52,35	52,35	52,35	
Контактная работа	52,35	52,35	52,35	52,35	
Сам. работа	119	119	119	119	
Часы на контроль	44,65	44,65	44,65	44,65	
Итого	216	216	216	216	

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Серебряков Андрей Евгеньевич

Рабочая программа дисциплины

MEMS-технологии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

 Φ ГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 959)

составлена на основании учебного плана:

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 26.01.2024 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Электронных приборов

Протокол от 30.05.2024 г. № 5 Срок действия программы: 2024-2026 уч.г. И.о. зав. кафедрой Серебряков Андрей Евгеньевич

	Визирование РПД для исполнения в очередном учебн	ом году
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2025-2026 учебном Электронных приборов		
	Протокол от 2025 г. №	
	Зав. кафедрой	
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебн	ом году
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2026-2027 учебном Электронных приборов		
	Протокол от 2026 г. №	
	Зав. кафедрой	
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебн	ом году
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2027-2028 учебном Электронных приборов		
	Протокол от2027 г. №	
	Зав. кафедрой	
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебн	ом году
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2028-2029 учебном		
Электронных приборов		
	Протокол от 2028 г. №	

Зав. кафедрой _____

TI: v11.04.04 24 00.plx ctp. 5

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
1	формирование базовых знаний в области MEMS-технологий, являющихся предпосылкой для возможностей практического использования преимуществ MEMS-датчиков при разработке, проектировании, производстве и применениях устройств электронной техники различного назначения.						
1	2 Задачи дисциплины:						
1	3 выработка навыков оценки новизны исследований и разработок MEMS-технологий, освоение новых методологических подходов к решению профессиональных задач в области электроники и наноэлектроники.						

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
L	Įикл (раздел) OП:					
2.1	Требования к предвари	гельной подготовке обучающегося:				
2.1.1	Инерциальные датчики					
2.1.2	Инерциальные датчики					
2.2	Дисциплины (модули) и предшествующее:	практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как				
2.2.1	Выполнение и защита вы	пускной квалификационной работы				
2.2.2	Преддипломная практика					

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Проводит анализ и выбор перспективных технологических процессов и оборудования производства приборов и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-1.1. Осуществляет сравнение характеристик и параметров существующих материалов, технологических процессов и оборудования производства приборов и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

базовые MEMS-технологии, используемые в них материалы электронной техники и специфику их применения, области применения MEMS-датчиков и требования к ним, механические и электрические характеристики чувствительных элементов MEMS-датчиков

Уметь

формулировать задачи при проектировании электронных устройств, включающих MEMS-датчики, обоснованно выбирать методы и средства их решения при максимальном использовании преимуществ MEMS-технологий

Владеть

методами контроля характеристик MEMS-датчиков и модулей на их основе

ПК-1.2. Собирает и систематизирует информацию о перспективных технологических процессах и оборудовании производства приборов и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Знать

типовые конструкционные и технологические решения, которые применяются при проектировании MEMS-датчиков различного назначения

Уметь

критически анализировать технические решения по применению MEMS-датчиков в задачах проектирования устройств электронной техники, осуществлять патентные исследования в области MEMS-технологий

Владеть

методиками подготовки научных публикаций и заявок на изобретения

ПК-4: Разрабатывает отдельные детали и узлы приборов ориентации и навигации

ПК-4.1. Выполняет теоретические изыскания принципов и путей создания новых образцов приборов ориентации и навигации

Знать

проблемы, препятствующие получению достоверной информации при использовании MEMS-датчиков в различных областях электроники и наноэлектроники

Уметь

критически оценивать содержание монографий, научных публикаций и патентов в области MEMS-технологий

Владеть

методиками патентного поиска и работы с источниками научной информации

ПК-4.2. Выполняет экспериментальные исследования новых образцов приборов ориентации, навигации

Знать

физические основы работы MEMS устройств, методы их анализа и компьютерного моделирования

Уметь

использовать MEMS-датчики при разработке устройств электроники и наноэлектроники.

Владеть

методами обработки выходных сигналов MEMS-датчиков в электронных устройствах.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	физические основы работы MEMS устройств, методы их анализа и компьютерного моделирования, базовые MEMS-технологии, используемые в них материалы электронной техники и специфику их применения, области применения MEMS-датчиков и требования к ним, механические и электрические характеристики чувствительных элементов MEMS-датчиков.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать MEMS-датчики при разработке устройств электроники и наноэлектроники, формулировать задачи при проектировании электронных устройств, включающих MEMS-датчики, обоснованно выбирать методы и средства их решения при максимальном использовании преимуществ MEMS-технологий.
3.3	Владеть:
3.3.1	методами обработки и контроля выходных сигналов MEMS-датчиков в электронных устройствах.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля	
	Раздел 1.						
1.1	Введение в дисциплину /Тема/	3	0				
1.2	Введение в дисциплину /Лек/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен	
1.3	История развития МЭМС. Изучение конспекта лекций. /Ср/	3	10	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен	
1.4	Изделия на магнитоуправляемых контактах /Тема/	3	0				
1.5	Изделия на магнитоуправляемых контактах /Лек/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен	

1.6	Расчет параметров магнитоуправляемых контактов /Пр/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4	Экзамен
				IIK-1.1-B IIK-1.2-3 IIK-1.2-V IIK-1.2-B IIK-4.1-3 IIK-4.1-Y IIK-4.1-B IIK-4.2-3 IIK-4.2-Y IIK-4.2-B	Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	
1.7	Разновидность магнитоуправляемых контактов. Изучение конспекта лекций. /Cp/	3	18	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.8	МЭМС-приборы /Тема/	3	0			
1.9	МЭМС-приборы /Ср/	3	19	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.10	Конструкции и принципы работы МЭМС- устройств. Изучение конспекта лекций. /Лек/	3	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.11	Основные технологии производства МЭМС- устройств в электронике /Тема/	3	0			
1.12	Основные технологические процессы изготовления МЭМС-компонентов. Изучение конспекта лекций. /Лек/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен

1.12	T A			TIV 4.4.2	П4 Л П4 В	0
1.13	Анализ результатов селективного травления с помощью оптического микроскопа. /Пр/	3	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.14	Исследование селективного травления в металлических структурах МЭМС. /Лаб/	3	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.15	Основные технологические процессы изготовления МЭМС-компонентов. Изучение конспекта лекций. /Ср/	3	20	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.16	Технологии нанесения контактных покрытий /Тема/	3	0			
1.17	Технологии нанесения контактных покрытий /Лек/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.18	Расчет функционального покрытия МЭМС на основе Ni-W /Пр/	3	4	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен

1.19	Осаждение функционального контактного покрытия Ni-W Осаждение функционального контактного покрытия Ni-W Осаждение функционального контактного покрытия Ni-W /Лаб/	3	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.20	Базовые технологические процессы нанесения контактных покрытий. Изучение конспекта лекций. /Ср/	3	2	IIK-1.1-3 IIK-1.1-Y IIK-1.1-B IIK-1.2-3 IIK-1.2-Y IIK-1.2-B IIK-4.1-3 IIK-4.1-Y IIK-4.1-B IIK-4.2-3 IIK-4.2-B	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.21	Свойства контактных покрытий МЭМС- устройств /Тема/	3	0			
1.22	/Лек/	3	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.23	Расчет диэлектрического слоя контактного покрытия, полученного методом электрохимического анодирования /Пр/	3	4	IIK-1.1-3 IIK-1.1-Y IIK-1.1-B IIK-1.2-3 IIK-1.2-Y IIK-1.2-B IIK-4.1-3 IIK-4.1-Y IIK-4.1-B IIK-4.2-3 IIK-4.2-Y IIK-4.2-B	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.24	Формирование диэлектрических покрытий методом электрохимического осаждения /Лаб/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.25	Основные параметры контактных покрытий МЭМС. Изучение конспекта лекций. /Cp/	3	20	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.26	Основные параметры и характеристики МЭМС- устройств /Тема/	3	0			

1.27	Основные параметры и характеристики МЭМС-устройств /Лек/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.28	Основные параметры и характеристики МЭМС-устройств /Пр/	3	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.29	Определение факторов, влияющих на основные параметры МЭМС-устройств. Изучение конспекта лекций. /Ср/	3	10	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.30	Диагностика параметров МЭМС- коммутаторов /Тема/	3	0			
1.31	Диагностика параметров МЭМС- коммутаторов /Лек/	3	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.32	Расчет параметров МЭМС-датчика /Пр/	3	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
1.33	Методики измерения основных параметров МЭМС. Изучение конспекта лекций. /Ср/	3	20	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
	Раздел 2.					
2.1	/Тема/	3	0			

2.2	/ИКР/	3	0,35	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
2.3	/Тема/	3	0			
2.4	Консультация /Кнс/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен
2.5	Экзамен /Экзамен/	3	44,65	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2	Экзамен

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «MEMS-технологии»).

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
	6.1. Рекомендуемая литература							
		6.1.1. Основная литература						
Nº	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС				
Л1.1	Мещеряков В. Н., Ласточкин Д. В.	Структурный анализ динамики электромеханических систем с упругими связями : учебное пособие	Липецк: Липецкий ГТУ, 2021, 81 с.	978-5-00175- 073-4, https://e.lanbo ok.com/book/2 47247				
Л1.2	Корнилович А.А., Литвинов В.Г.	Специальные главы современной физики и наноэлектроники: учеб. пособие : Учебное пособие	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2022,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3958				

Nº	A proper cograpuro au	1	Заглавие	Издательство,	Количество/	
IN⊡	Авторы, составители		Эаглавие	издательство, год	название ЭБС	
Л1.3	Лозовский В. Н.,		и в электронике. Введение в специальность :	Санкт-	978-5-507-	
	Лозовский С. В.	учебное пособ	ие для вузов	Петербург: Лань, 2024, 332	47532-2, https://e.lanbo	
				Лань, 2024, 552	ok.com/book/3	
					86429	
Л1.4	Смирнов Ю. А.,		электроники и микропроцессорной техники:	Санкт-	978-5-507-	
	Соколов С. В., Титов	учебное пособ	ие для спо	Петербург:	49425-5,	
	E. B.			Лань, 2024, 496 с.	https://e.lanbo ok.com/book/3	
				C.	90653	
Л1.5	Рыбин Н.Б., Рыбина	Технология из,	целий микроэлектроники : учеб. пособие	Рязань, 2023,	978-5-7722-	
	H.B.			160c.	0389-7, 1	
			2.1.2 H			
N _o	6.1.2. Дополнительная литература					
Nº	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л2.1	Резнев А.А., Вернер	Тенденции раз	вития МЭМС	М.: Амиант,	978-5-4231-	
	В.Д.			2010, 273 с.: ил.	0042-1, 1	
				ил.		
Л2.2	под ред. Ю.А.	Нанотехнологи	и в электронике	M.:	978-5-94836-	
	Чаплыгина			Техносфера, 2013, 686с.	353-0, 1	
				2013, 0000.		
Л2.3	Варадан В., Виной К.,	DII MOMO	V	М.:Техносфера	5-94836-030-	
712.3	Джозе К.	БЧ МЭМС и и	ВЧ МЭМС и их применение		X, 1	
				, 2004, 528c.		
		l	6.1.3. Методические разработки		1	
No	Авторы, составители	Заглавие		Издательство,	Количество/	
				год	название ЭБС	
Л3.1	Степашкин А.И.	Электромехані	ческие системы : Метод.указ.к лаб.работам	Рязань, 2002,	, 1	
			-	24c.		
Л3.2	Иконников, С. Е.,		ческие системы : учебно-методическое	Москва:	2227-8397,	
	Антонов, Д. А.	пособие		Российский	https://www.ip	
				университет транспорта	rbookshop.ru/ 116017.html	
				(МИИТ), 2019,	11001/.11(1111	
				107 c.		
	6.3 Переч	ень п <u>рограмм</u> і	ого обеспечения и информационных справоч	ных систем		
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства						
Наименование Описание						
6.3.2 Перечень информационных справочных систем						

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
1	103 лабораторный корпус. помещение для самостоятельной работы обучающихся, компьютерный класс Специализированная мебель (24 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ			

2

214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания дисциплины «МЕМЅ-технологии»)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Серебряков Андрей 27.08.24 17:36 (MSK) Простая подпись ЗАВЕДУЮЩИМ Евгеньевич, и.о. заведующего кафедры ЭП КАФЕДРЫ ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Серебряков Андрей 27.08.24 17:36 (MSK) Простая подпись ЗАВЕДУЮЩИМ Евгеньевич, и.о. заведующего кафедры ЭП ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Ерзылёва Анна 29.08.24 13:36 (MSK) Простая подпись НАЧАЛЬНИКОМ УРОП Александровна, Начальник УРОП